

## アプリケーション

アイスモスのカスタマイズされたダブル SOI (DSOI) は以下のような分野で使われております:

- MEMS/MST 向け SOI ソリューション
- マイクロ流体力学/フローセンサー
- RF MEMS
- 光マクロマシーン
- 光エレクトロニクス
- 光学 MEMS

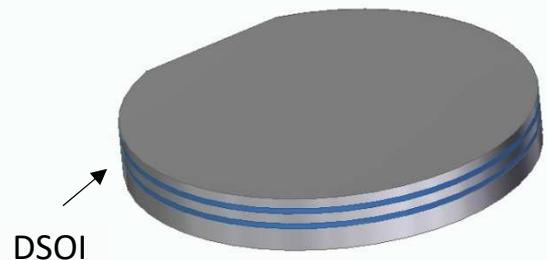
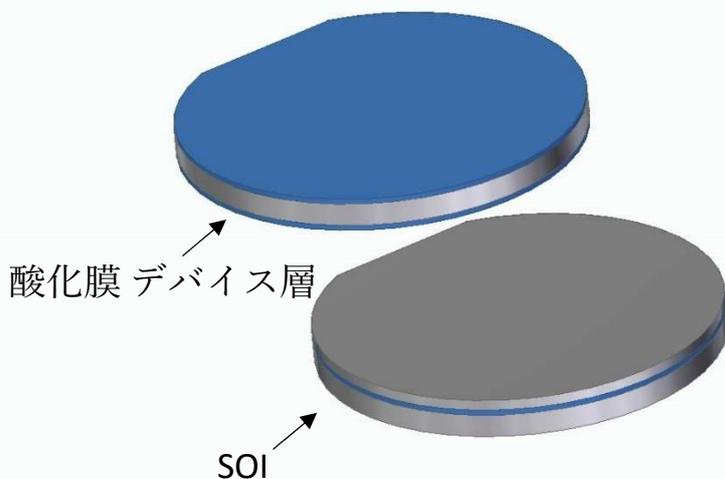
## 最終市場:

- テレコミュニケーション
- 医療
- 自動車
- 家電
- セキュリティ

アイスモス・テクノロジーは DSOI のリーディングサプライヤーです。DSOI は IC や MEMS 用に幅広くつかわれております。SOI 製造の 20 年以上の経験をもとに、私たちは幅広い市場で応用できるような興味深い仕様範囲の材料で完全な DSOI の解決法をご提供します。広範囲な SOI 経験がありますので、アプリケーションエンジニアがお客様の DSOI ウェハをプロセスするのに最適なパラメーターの組み合わせの選択をお手伝いします。

自由度の高いアプローチでアイスモスはお客様の実験開発レベルの少量ロットから、量産までご対応します。MEMS プロセスエンジニアは光学、慣性、生体や他の MEMS 分野においても経験があります。アイスモスは追加のファウンドリーサービスとして MEMS やトレンチエッチング、隔離構造なども提供いたします。

6 シグマの統計学的管理手法に基づくプロセスにおいて、常に継続的改善を進めながら、アイスモスは世界クラスの製品品質と、十分に競争できるコストと常に上昇するための方針を見定めながら、アイスモスは御社の DSOI の理想的なパートナーであり続けます。



## DSOI Specification

パラメーター	仕様 範囲	
ウエハー直径	100, 125, 150 mm	200 mm
<b>ハンドル層仕様</b>		
ハンドル層 厚さ	200-1100 $\mu\text{m}$	450-1100 $\mu\text{m}$
ハンドル 厚さ 公差範囲	$\pm 5 \mu\text{m}$	
重ね厚さ 範囲	280-1150 $\mu\text{m}$	
ドーパント タイプ	N または P	
ドーピング	N type: Phos, Red Phos, Sb & As P type: Boron	
抵抗率	$\leq 0.001 - \geq 10000 \Omega\text{-cm}$	
シリコン成長方法	CZ, MCZ or FZ	
結晶方位	$\langle 100 \rangle$ , $\langle 111 \rangle$ or $\langle 110 \rangle$	
裏面処理	ラップ仕上げ/エッチングまたはポリッシュ磨きによる	
<b>埋め込み酸化膜仕様</b>		
熱酸化膜、埋め込み酸化膜厚	0.2 - 4.0 $\mu\text{m}$ 成長 ハンドル、デバイスもしくは両ウエハーによる	
<b>デバイス層の仕様(第一、第二層)</b>		
デバイス層 膜厚	$\geq 1.5 \mu\text{m}$	$\geq 5 \mu\text{m}$
デバイス 厚さ 公差範囲	$\pm 0.5 \mu\text{m}$ and $\pm 1 \mu\text{m}$	$\pm 0.8 \mu\text{m}$ and $\pm 1.6 \mu\text{m}$
ドーパントタイプ	N または P	
ドーピング	N type: Phos, Red Phos, Sb & As P type: Boron	
抵抗率	$\leq 0.001 - \geq 10000 \Omega\text{-cm}$	
シリコン成長方法	CZ, MCZ or FZ	
結晶方位	$\langle 100 \rangle$ , $\langle 111 \rangle$ or $\langle 110 \rangle$	
<p>上記は標準の仕様ですが、特定の仕様のソリューションについて、喜んでお客様のご要望を検討させていただきます。 他のスペックなどお問合せなどがありましたら、セールsteamへコンタクトして下さい: <a href="mailto:sales@icemostech.com">sales@icemostech.com</a></p>		